

Organizácia Výročného ústavného seminára 2016

Pokyn riaditeľa EIÚ SAV

Na základe dohody s Vedeckou radou Elektrotechnického ústavu sa v utorok dňa 13. decembra 2016 uskutoční koncoročný ústavný seminár s cieľom informovať o zaujímavých vedeckých výsledkoch dosiahnutých na EIÚ v r. 2016.

Každé oddelenie má na prezentáciu vyhradený čas 1hodina a 20 minút. Najprv vedúci oddelenia uvedie vedecké zameranie oddelenia a najhodnotnejšie výsledky dosiahnuté v roku 2016, problémy, s ktorými sa oddelenie v r. 2016 stretlo a víziu ďalšieho smerovania oddelenia (čas - do 10 min). Následne vybraní pracovníci (počet 2-5) prezentujú svoje výsledky formou konferenčných príspevkov, pričom musí ostať aspoň 10 min na diskusiu.

Príspevky môžu byť v slovenčine, premietaný text prezentácie by mal byť v anglickom jazyku. Vedecká rada hneď po seminári vyhodnotí 3 najlepšie príspevky, ktorých autori (resp. autorské kolektívy) budú odmenené sumami 1000 €, 600 € a 400 €.

Vedúci oddelení dodajú do 9. 12. 2016 A. Gömörövej nasledovné podklady:

- vyplnený dotazník činnosti vedeckých oddelení (tlačenú aj el. verziu) za r. 2016,
- kópie publikácií oddelenia publikovaných v roku 2016,
- zoznam príspevkov oddelenia prezentovaných na Výročnom seminári 2016.

Po vyhlásení výsledkov bude spoločné posedenie pracovníkov ústavu s pohostením. Na posedenie sú pozvaní všetci pracovníci ústavu.

ČASOVÝ PRIEBEH SEMINÁRA (utorok 13.12. 2016)

8:55 – 9:00	Zahájenie
9:00 – 10:20	OFS Ing. P. Kováč, DrSc.
10:30 – 11:50	OTPP Ing. J. Kuzmík, DrSc.
11:50 – 12:30	Obedňajšia prestávka
12:30 – 13:50	OMS RNDr. B. Zaťko, CSc.
14:00 – 15:20	OFTN Dr. rer. nat. M. Hulman
15:20 – 16:00	Zasadnutie VR, vyhodnotenie súťaže
16:00 –	Vyhlásenie výsledkov, posedenie pracovníkov ústavu

V Bratislave, 22.11. 2016



RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.

Zoznam prednášok

9,00 hod. OS

1. P. Kováč: Light MgB₂ superconductor
2. B. Brunner: Doped IMD MgB₂
3. L. Kopera: Rutherford MgB₂ cables
4. E. Pardo: FEM analysis and modeling
5. M. Vojenčiak: Superconducting fault current limiter
6. J. Šouc: Magnetic shield

10,30 hod. OTPP

1. Blaho, M.: Technology of integrated self-aligned E/D-mode n⁺⁺GaN/InAlN/AlN/GaN MOS HEMTs for mixed-signal electronics.
2. Ľapajna, M.: Gate reliability investigation in normally-off p-type-GaN cap/AlGaN/GaN HEMTs under forward bias stress
3. J. Novák: Reinforcement role of GaP nanowires in a ZnO layer prepared by RF sputtering.

12,30 hod. OMS

1. Š. Chromik: Low energy electron beam processing of superconducting YBCO thin films
2. G. Vanko: Transistors on the base of progressive materials for high temperatures
3. B. Zaťko: Neutron detectors based on 4H-SiC epitaxial layer

14,00 hod. OFTN

1. J. Tóbiš: Metadynamics - local minima search algorithm
2. J. Šoltýs: Cantilever Based Sensors
3. M. Mruckiewicz: Spin Wave Excitations in Ultrathin Nanostructures with Dzyaloshinskii-Moriya Interactions
4. M. Hulman: 2D materials - results and perspectives